



Title of Change:	Update Datasheet limit for 4A and 5A, 100V Low Leakage Trench-based Schottky Rectifiers.							
Effective date:	1 October 2018							
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Phuong.Hoang@onsemi.com>							
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.							
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☐ Assembly Change ☐ Test Change ☒ Other <u>Datasheet</u>							
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☐ Material Change ☒ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____							
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia ON Dong Nai Province, Vietnam	External Foundry/Subcon Sites: None						
Description and Purpose: This Product Bulletin is to announce the change of the room temperature (25degC) reverse leakage limit for 4A and 5A, 100V Low Leakage Trench-based Schottky Rectifiers.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Change from</th> <th>Change to</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IR @ 100V (T_J = 25C)</td> <td>9uA</td> <td>29uA</td> </tr> </tbody> </table>				Change from	Change to	IR @ 100V (T _J = 25C)	9uA	29uA
	Change from	Change to						
IR @ 100V (T _J = 25C)	9uA	29uA						
As this change affects only the room temperature electrical characteristic, only required characterization testing and no product reliability required. This change is a correction to the clerical error on the datasheet, there will be no change to the electrical or thermal performance of the device.								
List of Affected Parts: NRV TSA4100ET3G NRV TSS5100ET3G NRV TSAF5100ET3G								

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



製品速報

文書番号: PB22464Z

発行日: 2018 年 9 月 28 日

変更件名:	4A および 5A、100V 低リーク・トレンチベースショットキー整流器のデータシートの更新。							
発効日:	2018 年 10 月 1 日							
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Phuong.Hoang@onsemi.com> にお問い合わせください。							
通知種別:	本製品速報は通知目的のみです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。							
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☐ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☒ その他 <u>データシート</u>							
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ 材料の変更 ☐ 製品仕様の変更 ☒ データシート/製品資料の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ その他: _____							
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: オン セレンバン(マレーシア) オン ドンナイ省(ベトナム)	外部製造工場 / 下請け業者拠点: なし						
説明および目的: 本製品速報は 4A および 5A、100V 低リーク・トレンチベースショットキー整流器の室温 (25度) 時逆電流のリミット変更を通知するためのものです。								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IR @ 100V (T_J = 25C)</td> <td>9uA</td> <td>29uA</td> </tr> </tbody> </table>				変更前	変更後	IR @ 100V (T _J = 25C)	9uA	29uA
	変更前	変更後						
IR @ 100V (T _J = 25C)	9uA	29uA						
本変更は室温時の電気的特性にのみ影響するため特性試験の実施のみで信頼性試験は行われません。本変更はデータシート上の誤記を訂正するもので、デバイスの電気的または熱的性能に変更はありません。								
影響を受ける部品の一覧: NRV TSA4100ET3G NRV TSS5100ET3G NRV TSAF5100ET3G								